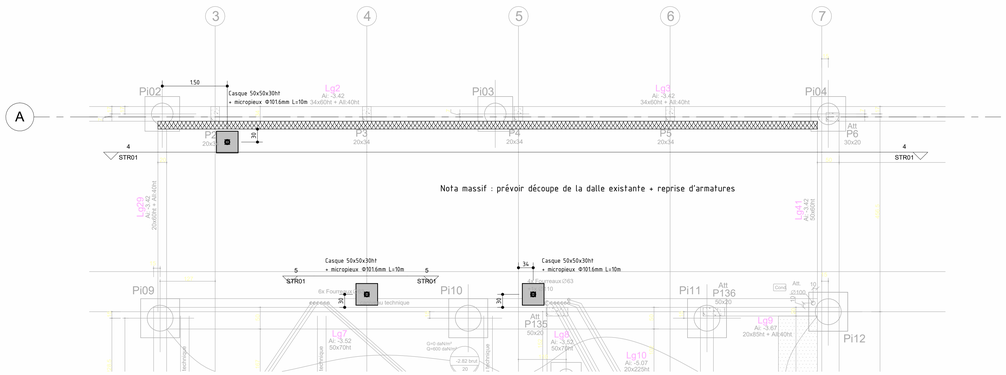
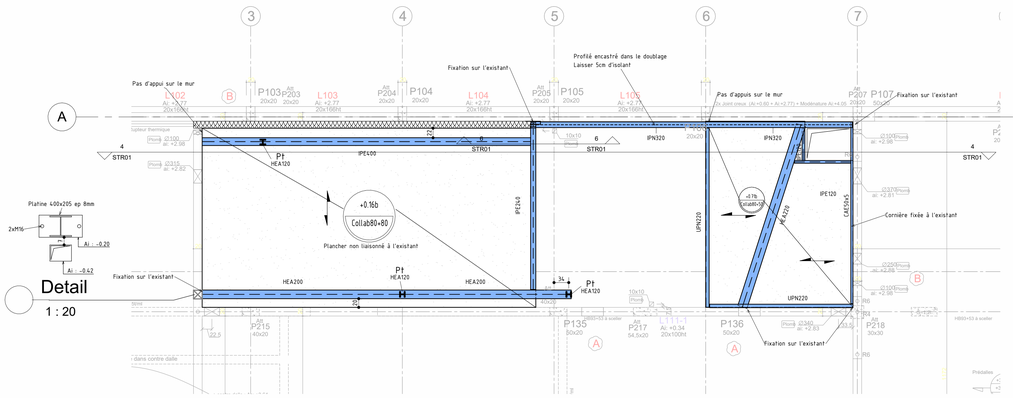


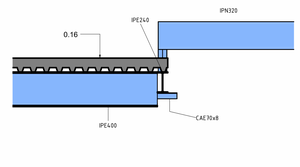
1 PB Fondation

1 : 50



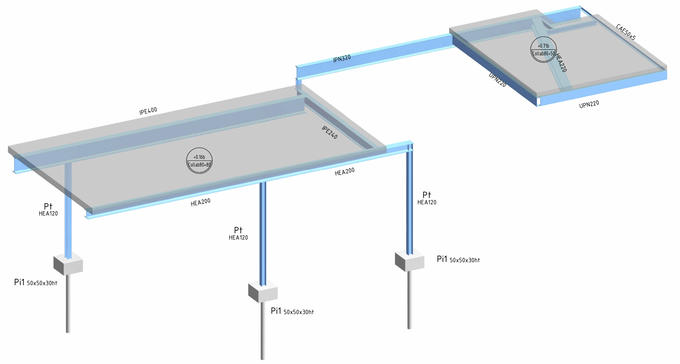
2 PH RDC

1 : 50

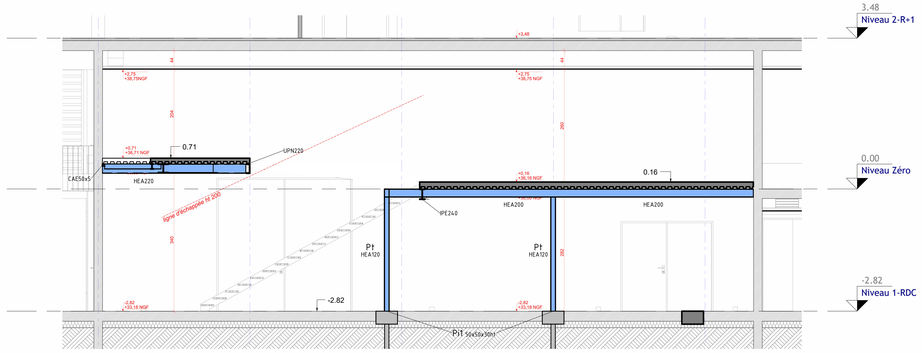


6 Détail coursive

1 : 25

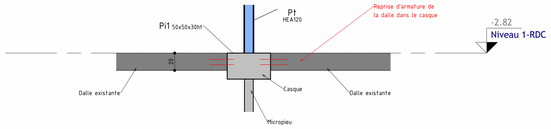


3 3D GENERALE



4 Coupe Longitudinale

1 : 50



5 Détail fondation

1 : 25

NOTA
- Le prédimensionnement indiqué sur ce plan est donné à titre indicatif - La cotation sommaire est donnée à titre indicatif, la cotation des plans architectes prime sur celles des plans de structure. - Pour les réservations et les gaines techniques seuls les plans fluides sont contractuels. - Sauf indication contraire l'épaisseur des voiles est de 20cm

LEGENDE	
Po	Poutre
PoC	Poutre en console
PoR	Poutre retroussée
PA	Poutre-Allège
PV	Poutre-Voile
TPV	Talon Poutre-Voile
TCV	Talon Console Voile
Lt	Linteau
Bn	Bande noyée
Pt	Poteau
JD	Joint de dilatation
	Mur béton non porteur
	Mur béton porteur
	Impact éléments verticaux du niveau supérieur
	Sens de portée du plancher
P: X%	Dalle en pente
	Rupteurs thermiques
	Trémie dans plancher
Ø20.00 / 20	Niveau supérieur brut Epaisseur dalle (cm) niveau fini rdc 00,00 = + 36,00 ngf

DESSINÉ PAR:	VERIFIÉ PAR:	VISA CHEF PROJET:	N° d'AFFAIRE:
NM	LC	O. DAVOST	BAPE724

Extension / Réhabilitation de l'Institut d'Electronique et deTélécommunication de Rennes
Bâtiment 11D - 188 Allée Jean Perrin - Campus Beaulieu - RENNES

MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITÉ D RENNES 1
2 RUE DE THABOR
35065 RENNES CEDEX
P: 02 23 23 36 70

ARCHITECTES

ANTHRACITE ARCHITECTURE
5, rue de l'horloge
35000 RENNES
T: 0299676221
contact@anthracite-architecture.com

BUREAU D'ÉTUDES

Egis Bâtiments Centre-Ouest
Zac de la Cournouze - Immeuble Eolios – 1er étage
3, rue Louis Braille
35136 St-Jacques-de-la-Lande
(adresse postale : TSA 50851 - 35208 RENNES Cédex 2
T: 0299657030
egis.batiments-rennes@egis.fr

DCE

PLAN DE PRINCIPE STRUCTURE
Halle Technologique

DATE : DEC.2024	
AFFAIRE : Halle Technologique	BAPE724